UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS DIVISION DE ESTUDIOS SUPERIORES



# NUEVOS CONDUCTORES DE-ION LITIO EN LOS SISTEMAS Li20-Al203-MO2, M=Si, Ge.

## TESIS

EN OPCION AL GRADO ACADEMICO DE: MAESTRO EN CIENCIAS ESPECIALIDAD: FISICOQUIMICA

> PRESENTA: ALEJANDRO GARCIA GARCIA

MONTERREY, N. L.

FEBRERO DE 1993









# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

# UNIMERSIOND AUTONOMIA DE NUEVO LEON

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN IN CITION AL DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

HEPECIALIDAD. FISRIERI MARCA

PRESERTAN

ALEJANDRO GARCIA GARCIA.

+2.54. PROFILE (

THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY



X



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

## UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

## FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

# NUEVOS CONDUCTORES DE ION LITIO EN LOS SISTEMAS Li<sub>2</sub>O-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-MO<sub>2</sub>, M = Si, Ge

**TESIS** 

EN OPCION AL GRADO ACADEMICO DE MAESTRO EN CIENCIAS ESPECIALIDAD : FISICOQUIMICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

PRESENTA:

**MONTERREY**, N.L.

FEBRERO 1993

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS DIVISION DE ESTUDIOS SUPERIORES

FEBRERO/1993

#### Q. I. ANDRES CERDA ONOFRE:

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

LA TESIS ELABORADA POR EL L. Q. I. ALEJANDRO GARCIA GARCIA, TITULADA " NUEVOS CONDUCTORES DEL ION LITIO EN LOS-SISTEMAS  $Li_2^0 - Al_2^0_3 - Mo_2$ , M = Si, Ge ", HA SIDO ACEPTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OPTAR AL GRADO ACADEMICO DE --MAESTRO EN CIENCIAS, ESPECIALIDAD FISICOQUIMICA.

a.M.West icia m

A DEDRA. LETICIA TORRES G. PROF. A. R. WEST

ASESOR DIRECCON GENER

DR. CARLOS GUERRERO S.

SECRETARIO

CO – ASESORA PRESIDENTE

DRA. PATRICIA QUINTANA

VOCAL

DRA. MARIBEL SUAREZ C. COORDINADORA DE LA ESCUELA DE GRADUA-

DOS EN CIENCIAS



SEÑOR.

## INDLCE GENERAL

RESUMEN	2
CAPITULO NO. 1	
Introducción	4
CAPITULO NO. 2	
TONOMExperimental	
2.1 Reactivos	11
2.2 Mezclas de reacción	11
2.3 Sinterización	12
2.4 Medición de propiedades eléctricas 2.5 Técnicas	13
2.5.1 Difracción de rayos X	13
2.5.2 Conductividad eléctrica	14
CAPITULO NO. 3 UNIVERSID Resultados para la unión Li <sub>A</sub> SiO <sub>4</sub> -LiAIS	15.ÓN
3.1 Cristaloquímica	16
D3.2 Conductividad eléctrica BIBLIOTECAS	23
3.2.1 Planos de impedancia compleja	25
3.2.2 Dependencia de la conductividad	
eléctrica con la temperatura	27
3.2.3 Dependencia de la conductividad	
eléctrica con la composición	30
CAPITULO NO. 4	
Resultados para la unión Li <sub>4</sub> GeO <sub>4</sub> -LiAlO	3e0 <sub>4</sub>
4.1 Cristaloquímica	71
4.2 Conductividad eléctrica	74
4.2.1 Planos de impedancia compleja	75
4.2.2 Dependencia de la conductividad	
eléctrica con la temperatura	7 <b>7</b>

		Pagina
4.2.3	Dependencia de la conductivid.a	
	eléctrica con la composición	79

CAPITULE NO. 5

Relación de resultados de conductividad eléctrica de las soluciones sólidas de fórmulas  $\text{Li}_{4-3X}\text{Al}_X\text{MO}_4$ , M = Si, Ge 106

CAPITULO NO. 6

REFERENCIAS

Conclusiones Generales

112

110

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS INDICE DE FIGURAS

No.		Página
		2
1	Intervalo de solución sólida en el sistema	
	$Li_20 - Al_20_3 - Si0_2$	16
2	Gráfica de distancia interplanar contra com-	
	posición	20
3	Diagrama esquemático de líneas•de difracción	
	de rayos X	21
4	Plano de impedancia compleja tipo 1	32
5	Plano de impedancia compleja tipo 2	32
6 9	Curva espectroscópica correspondiente a la -	
RS	lución sólida $Li_{4-3X}Al_{X}SiO_{4}$ , X = 0.60	33
75	Curva espectroscópica correspondiente a la -	
E	lución sólida $\text{Li}_{4-3X}\text{Al}_{X}\text{SiO}_{4}$ , X = 0.10	34
8	Planos de impedancia compleja para la solución	
	sólida $\text{Li}_{4-3x}\text{Al}_x\text{SiO}_4$ , X = 0.10	35
9	Planos de impedancia compleja para la solución	
UN	sólida Li <sub>4-3X</sub> Al <sub>x</sub> SiO <sub>4</sub> , X = 0.15 A DE NUEVO	I 36ÓN
10	Planos de impedancia compleja para la solución	
	sólida Li <sub>4-3X</sub> Al <sub>x</sub> SiO <sub>4</sub> , X <sub>R=A</sub> 0.20 E BIBLIOTEC	<u>s</u> 37
11 .	Planos de impedancia compleja para la solución	
	sólida $\text{Li}_{4-3X}\text{Al}_{X}\text{SiO}_{4}$ , X = 0.225	38
12	Planos de impedancia compleja para la solución	
	sólida $Li_{4-3X}Al_{x}SiO_{4}$ , X = 0.25	39
13	Planos de impedancia compleja para la solución	
	sólida $\text{Li}_{4-3\chi}\text{Al}_{\chi}\text{SiO}_{4}$ , X = 0.2625	40
14	Planos de impedancia compleja para la solución	
	sólida Lí <sub>4-3X</sub> Al <sub>x</sub> SiO <sub>4</sub> , X = 0.275	41
15	Planos de impedancia compleja para la solución	
	sólida $\text{Li}_{4-3X}^{\text{Al}} \text{SiO}_{4}$ , X = 0.30	42
16	Planos de impedancia compleja para la solución	
	sólida $Li_{4-3X}Al_{X}SiO_{4}$ , X = 0.325	43
	ing a start to the	

No.	•

17	Planos de impedancia compleja para la solución	
	sólida $Li_{4-3X}Al_{X}SiO_{4}, X = 0.35$	44
18	Planos de impedancia compleja para la solución	
	sólida $Li_{4-3X}Al_XSiO_4$ , $X = 0.40$	45
19	Planos de impedancia compleja para la solución	
	sólida Li <sub>4-3X</sub> Al <sub>X</sub> SiO <sub>4</sub> , X = 0.45	46
20	Planos de impedancia compleja para la solución	
	sólida $Li_{4-3X}Al_XSiO_4$ , X = 0.50	47
21	Planos de impedancia compleja para la solución	
	sólida $Li_{4-3X}Al_{X}SiO_{4}$ , $X = 0.55^{\circ}$	49
22	Planos de impedancia compleja para la solución	
	sólida Li <sub>4-3X</sub> $Al_XSiO_4$ , X = 0.60	50
23	Gráficas de conductividad de Arrhenius para la	
S	solución sólida Li <sub>4-3X</sub> Al <sub>x</sub> SiO <sub>4</sub>	51
24	Gráficas de Arrhenius de conductividad para la	
E	solución sólida Li <sub>4-3X</sub> Al <sub>x</sub> SiO <sub>4</sub>	52
25	Dependencia de la conductividad eléctrica con	
	la composición de Li <sub>4-3x</sub> Al <sub>x</sub> SiO <sub>4</sub>	53
26	Intervalo de solución sólida estudiado en el -	
TIN	sistema $Li_2^0 - Al_2^0_3 = Ge0_2$	71
28	Planos de impedancia compleja para la solución	EON
	sólida $\text{Li}_{4-3X}\text{Al}_{X}\text{GeO}_{4}$ , X = 0.10	82
29	Planos de impedancia compleja para la solución	
	solida $\text{Li}_{4-3X}\text{Al}_X\text{GeO}_4$ , $X = 0.20$	83
30	Planos de impedancia compleja para la solución	
	sólida $Li_{4-3X}Al_{X}GeO_{4}$ , X = 0.30	84
31	Planos de impedancia compleja para la solución	
	sólida $Li_{4-3X}Al_{X}GeO_{4}$ , X = 0.35	85
<b>3</b> 2	Planos de impedancia compleja para la solución	
	Sólida $\text{Li}_{4-3X}\text{Al}_X\text{GeO}_4$ , X = 0.50	86
33	Gráficas de conductividad de Arrhenius para la	
	solución sólida Li <sub>4-3X</sub> Al <sub>x</sub> GeO <sub>4</sub>	87
34	Gráficas de conductividad de Arrhenius para la	
	solución sólida $Li_{4-3X}Al_XGeO_4$	88

No.		Página
35	Dependencia de la com	nductividad eléctrica con
	la composición para	$Li_{4-3x}Al_{x}GeO_{4}$ 89
36	Isotermas de conduct	ividad eléctrica para las
	soluciones sólidas L	i <sub>4-3x</sub> A1 <sub>x</sub> GeO <sub>4</sub> , Li <sub>4-3x</sub> A1 <sub>x</sub> SiO <sub>4</sub>
	y Li <sub>4-3X</sub> Ga <sub>X</sub> SiO <sub>4</sub>	107



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

NO.		Página
1	Deter de dificientés de rever V en polyon	
T	Datos de difracción de rayos x en porvos	10
255	para el $-Li_5^{AISI}2^0_8$	19
2	Resultados de conductividad eléctrica p <u>a</u>	
	ra el $Li_{4-3X}^*$ Al <sub>X</sub> SiO <sub>4</sub> , siendo X = 0.10	54
3	Resultados de conductividad eléctrica pa	
.*	ra el Li <sub>4-3X</sub> $A1_XSiO_4$ , siendo X = 0.15	55
4	Resultados de conductividad eléctrica pa	
	ra el $Li_{4-3X}Al_XSiO_4$ , siendo X = 0.20	56
5	Resultados de conductividad eléctrica pa	
	ra el $\text{Li}_{4-3X}\text{Al}_{X}\text{SiO}_{4}$ , siendo X = 0.225	' 57
6 ALERE	Resultados de conductividad eléctrica pa	
8	ra el $Li_{4-3X}Al_{X}SiO_{4}$ , siendo X = 0.25	58
2 7	Resultados de conductividad eléctrica pa	
B	ra el Li <sub>4-3X</sub> Al <sub>x</sub> SiO <sub>4</sub> , siendo X = 0.2625	59
8	Resultados de conductividad eléctrica pa	5.
	ra el $li_{4-3X}Al_{x}SiO_{1}$ , siendo X = 0.275	60
9	Resultados de conductividad eléctrica pa	
	ra el $Li_{4-3x}Al_{x}SiO_{4}$ , siendo X = 0.30	61
IINIIOFP	Resultados de conductividad eléctrica pa	FÓN
UNE	ra el Li <sub>A-3x</sub> Al <sub>y</sub> SiO <sub>4</sub> , siendo X = 0.325	62
1DID	Resultados de conductividad eléctrica pa	
*DIK	ra el Lia $2xAl_{y}Si0$ , siendo X = 0.35	63
12	Resultados de conductividad eléctrica na	
14	ra el Liz $avAl_siO_s$ ciendo X = 0.40	64
1 2	Resultados de conductividad eléctrica pa	0.
13	$r_{a}$ of $li_{a}$ and $si0$ giando $V = 0.45$	65
	$\frac{14}{14} = \frac{14}{3} \frac{3}{14} \frac{3}{3} \frac{3}{14} \frac{3}{14}$	0.9
14	resolution de conductividad electrica pa	66
	ra er $L^{1}4-3X^{A1}X^{S10}4$ , siendo $X = 0.50$	00
15	Resultados de conductividad eléctrica pa	17
1	ra el Li <sub>4-3X</sub> <sup>AL</sup> X <sup>SIO</sup> <sub>4</sub> , siendo X = 0.55	67

2

ŝ

T		1
D n	0.7	m n
1 0	×т	LI a
	$\circ -$	

ġ.

16	Resultados de conductividad eléctrica pa	
	ra el $Li_{4-3X}Al_{x}SiO_{4}$ , siendo X = 0.60	68
17a	Parámetros de la ecuación de Arrhenius -	
	para Li <sub>4-3x</sub> Ak <sub>x</sub> SiO <sub>4</sub>	69
17ь	Resultados de conductividad eléctrica pa	
-	ra el $Li_{4-3X}Al_{x}GeO_{4}$ , siendo X = 0.10	90
18	Resultados de conductividad eléctrica pa	
85	ra el Li <sub>4-3X</sub> Al <sub>X</sub> GeO <sub>4</sub> , siendo X = 0.125	91
19	Resultados de conductividad eléctrica pa	a.
	ra el Li <sub>4-3X</sub> A1 <sub>x</sub> GeO <sub>4</sub> , siendo X = 0.15	92
20	Resultados de conductividad eléctrica pa	
<u>Š</u>	ra el Li <sub>4-3X</sub> Al <sub>x</sub> GeO <sub>4</sub> , siendo X = 0.175	93
21	Resultados de conductividad eléctrica pa	
E	ra el Li <sub>4-3X</sub> Al <sub>x</sub> GeO <sub>4</sub> , siendo X = 0.20	94
22	Resultados de conductividad eléctrica pa	
NY I	ra el Li <sub>4-3X</sub> A1 <sub>X</sub> GeO <sub>4</sub> , siendo X = 0.225	95
23	Resultados de conductividad eléctrica pa	
	ra el $Li_{4-3X}Al_XGeO_4$ , siendo X = 0.25	96
24	Resultados de conductividad eléctrica pa	IFÓN
UNI	ra el $\text{Li}_{4-3X}\text{Al}_X\text{GeO}_4$ , siendo X = 0.275	97
25	Resultados de conductividad eléctrica pa	C
	ra el Li <sub>4-3X</sub> Al <sub>X</sub> CeO <sub>4</sub> , siendo X = 0.30	98
26	Resultados de conductividad eléctrica pa	
	ra el $Li_{4-3X}Al_XGeO_4$ , siendo X = 0.325	99
27	Resultados de conductividad eléctrica pa	
	ra el $Li_{4-3X}Al_{X}GeO_{4}$ , siendo X = 0.35	100
28	Resultados de conductividad eléctrica pa	
	ra el $Li_{4-3X}Al_{X}GeO_{4}$ , siendo X = 0.40	101
29	Resultados de conductividad eléctrica pa	
	ra el $Li_{4-3X}Al_{X}GeO_{4}$ , siendo X = 0.45	102
30	Resultados de conductividad eléctrica pa	
	ra el Li <sub>A-3x</sub> Al <sub>x</sub> GeO <sub>4</sub> , siendo X = 0.50	103

NO.

a

104

31 Parámetros de la ecuación de Arrhenius para Li<sub>4-3X</sub>A1<sub>X</sub><sup>GeO</sup>4



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN OIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

#### RESUMEN

El presente trabajo plantea como objetivo principal la síntesis y caracterización de nuevos compuestos cerámicos, en los sistemas  $\text{Li}_20 - \text{Al}_20_3 - \text{SiO}_2$  y  $\text{Li}_20 - \text{Al}_20_3 - \text{GeO}_2$ , específicamente en las líneas de unión  $\text{Li}_4\text{SiO}_4 - \text{LiAlSiO}_4$  y  $\text{Li}_4\text{GeO}_4$ -LiAlGeO<sub>4</sub>, respectivamente.

Las síntesis se llevaron a cabo por el método de reacción en estado sólido y la caracterización cristaloquímica de los compuestos obtenidos se realizó mediante difracción de rayos X de polvos, utilizando una cámara Hagg-Guinier con radiación Cu<sub>k<1</sub>.

Se encontró la existencia de soluciones sólidas en las líneas de unión mencionadas, tanto en el sistema conteniendo -Si como en el sistema con Ge.

#### UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

De cada una de las soluciones sólidas sintetizadas, se evaluó su comportamiento eléctrico dentro de un intervalo de temperatura de - 20 °C a 275 °C, empleando para ello dos anal<u>i</u> zadores de impedancia de respuesta a la frecuencia, controla--dos por un sistema computarizado.

Los resultados de conductividad eléctrica obtenidos -fueron del orden de  $10^{-4}$  Ohm<sup>-1</sup> cm<sup>-1</sup> para el sistema conteniendo Ge, y del orden de  $10^{-5}$  Ohm<sup>-1</sup> cm<sup>-1</sup> para el sistema con Si, ambos valores a una temperatura de 100 °C.



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

#### INTRODUCCION

En los últimos años se ha registrado una revolución en el campo de la electroquímica del estado sólido, debido al deg cubrimiento de sólidos inorgánicos con una capacidad de conduç ción eléctrica comparable a la de algunos electrólitos acuosos [ 1 ]. La conducción eléctrica, para cualquier material, ocu-rre por la migración de sus electrones o de sus iones. Por lo general, uno de los tipos de migración es el que predomina.

Los compuestos sólidos iónicos son aquellos que presen tan una alta conductividad iónica, independientemente de que se encuentre presente la conductividad electrónica o no. Den-tro de este grupo de compuestos se encuentran los electrólitos sólidos, que son materiales con una alta conductividad iónica, ya sea catiónica o aniónica, y una conductividad electrónica de magnitud despreciable. Representan el equivalente de las sg les fundidas o bien de los electrólitos fuertes líquidos. En ocasiones se les denomina conductores superiónicos o conductores de iones rápidos.

Junto a los electrólitos sólidos, para los que el núme ro de transporte iónico es la unidad, existe un grupo de materiales que exhiben, al mismo tiempo, ambos tipos de conductiv<u>i</u> dad. Estos son llamados conductores mixtos, materiales de in---

- 4 -

tercalación o electrodos de solución sólida.

Los electrólitos sólidos no son materiales cristalinos exclusivamente, de hecho la mayoría de estos últimos, como clo ruro de sodio y óxido de magnesio, poseen una baja conductividad iónica porque, aunque los átomos o iones están sometidos a vibraciones térmicas, usualmente la energía implicada en ellas no es lo suficientemente grande como para que puedan escapar o moverse a lo largo de la estructura. El pequeño grupo de electrólitos sólidos constituyen una excepción. En éstos, un compo nente de la estructura, catiónico o aniónico, no está confinado a sitios específicos dentro del enrejado cristalino, sino que esencialmente se encuentra libre para desplazarse a través de dicha estructura. Los electrólitos sólidos son por lo tanto, intermedios en estructura y propiedades por un lado, entre sólidos cristalinos tradicionales con estructuras tridimensionales regulares y átomos o iones inmóviles, y por el otro lado, entre electrólitos líquidos que no tienen estructuras regula-res, pero que poseen iones móviles.

Los defectos puntuales son los responsables de la conducción eléctrica. Los sólidos iónicos poseen estos defectos a cualquier temperatura artiba de cero Kelvin. J. Frenkel [ 2 ] y W. Schottky [ 3 ] desarrollaron modelos microscópicos clásicos que mostraban como mediante " saltos iónicos ", entre posiciones vacantes o intersticiales ( defectos puntuales ) en la es-

- 5 -

tructura rígida, se originaba una migración de iones. La creación de defectos iónicos se puede lograr al introducir impurezas a un material con una estructura capaz de aceptarlas. Tal es el caso del  $\text{Li}_4 XO_4$ , en donde X = Si, Ge, Ti, que poseen estructuras adecuadas para formar soluciones sólidas, por ejem-plo  $\text{Li}_4 SiO_4 - \text{Li}_5 AlO_4$ , [ 4 ]. En estas soluciones sólidas la conductividad se incrementa varios órdenes de magnitud, comparada con la conductividad de los miembros terminales. En general, se pueden establecer las siguientes características es---tructurales necesarias para que un material presente una com--ductividad iónica alta:

- i ) Un gran número de sitios vacíos para los iones móviles.
  ii ) Sitios vacíos y ocupados energéticamente equivalentes con energías de activación relativamente bajas.
- iii) Los sitios vacíos y ocupados deben estar interconectados formando canales de transporte a través de los cuales los iones puedan migrar, [ 5,6 ].

La conductividad del ión litio en sistemas tipo óxidos cerámicos ha sido ampliamente estudiada en diferentes grupos de materiales entre los que se pueden mencionar fases tipo --- $Li_4SiO_4$ , [7,8], soluciones sólidas 3, incluyendo LISICON obtenido a partir de fases estequiométricas como  $Li_3PO_4$  y  $Li_2ZnGeO_4$ [4, 9, 10], y aquellos con estructuras tipo silicatos, inclu-yendo eucriptita,  $LiAlSiO_4$  [ 11 ]. El valor más alto de condu<u>c</u> tividad que se ha reportado en los materiales anteriores es de  $4 \times 10^{-5}$  Ohm<sup>-1</sup> cm<sup>-1</sup> a 25 °C, incrementándose a  $10^{-1}$  Ohm<sup>-1</sup> cm<sup>-1</sup> cuando la temperatura es de 300 °C. El valor de la conductividad a 25 °C se encuentra varios órdenes de magnitud por debajo de los que se reportan para los mejores conductores iónicos de Ag<sup>+</sup> y Na<sup>+</sup>; no obstante, se podrían sintetizar nuevos compues---tos de Li<sup>+</sup> con mejores características de conductividad eléc---trica ( mayores valores de conductividad eléctrica a temperatura ambiente ).

El sistema Li<sub>2</sub>0 - Al<sub>2</sub>0<sub>3</sub> - SiO<sub>2</sub> ha sido estudiado anteriormente en las líneas de unión Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub> - Li<sub>5</sub>AlO<sub>4</sub> y Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub> - LiAlSiO<sub>4</sub>, [11], informándose de valores de conductividad del orden de 10<sup>-1</sup> y 10<sup>-2</sup> Ohm<sup>-1</sup> cm<sup>-1</sup>, respectivamente, a una temperatura de 300 °C. Así mismo se publica que en la unión Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub> - Li<sub>5</sub>AlO<sub>4</sub> se forma una solución sólida en un intervalo de composición de  $0 < X \le 0.40$ , cuya fórmula es Li<sub>4+X</sub>Al<sub>X</sub>Si<sub>1-X</sub>O<sub>4</sub>. Por otro lado, en la unión Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub> - LiAlSiO<sub>4</sub> se informa de la for mación de una solución sólida de fórmula Li<sub>4-3X</sub>Al<sub>X</sub>SiO<sub>4</sub>, pero - dentro de un intervalo de composición mucho más estrecho, ---- 0 < X < 0.06.

Posteriormente se publica el estudio efectuado en el sistema  $\text{Li}_20$  -  $\text{Ga}_20_3$  -  $\text{SiO}_2$ , [12], del que se esperaría un comportamiento similar al encontardo en el sistema  $\text{Li}_20$  -  $\text{Al}_20_3$ -  $\text{SiO}_2$ , dado que solamente se sustituye al  $\text{Al}^{+3}$  por  $\text{Ga}^{+3}$ , y es tos cationes guardan una estrecha relación entre sí. En la linea de unión  $\text{Li}_4\text{SiO}_4$  -  $\text{Li}_5\text{GaO}_4$  se presenta la formación de una solución sólida de fórmula  $\text{Li}_{4+X}\text{Ga}_X\text{Si}_{1-X}\text{O}_4$ , siendo 0 < X < 0.30, La conductividad de esta fase, a una temperatura de 300 °C, es de aproximadamente 1 Ohm<sup>-1</sup> cm<sup>-1</sup>. Acerca de la línea de unión - $\text{Li}_4\text{SiO}_4$  -  $\text{Li}\text{Ga}\text{SiO}_4$ , se observa la formación de una solución só lida de fórmula  $\text{Li}_{4-3X}\text{Ga}_X\text{SiO}_4$  dentro de un intervalo de composición  $0 < X \le 0.60$ , con una conductividad eléctrica de 1 x 10<sup>-4</sup> Ohm<sup>-1</sup> cm<sup>-1</sup>, a una temperatura de 300 °C.

Resultó extraño que en el sistema  $\text{Li}_20 - \text{Al}_20_3 - \text{SiO}_2$ , la formación de una solución sólida estuviese restringida a un intervalo tan pequeño de composición, Este comportamiento "an<u>ó</u> malo" fue lo que dió lugar al presente trabajo.

Posteriormente, como parte de este trabajo de tesis, se efectuó el estudio del sistema conteniendo germanio en lu-gar de silicio, es decir,  $\text{Li}_2^0 - \text{Al}_2^0_3 - \text{GeO}_2$ , específicamente en la línea de unión  $\text{Li}_4\text{GeO}_4 - \text{LiAlGeO}_4$ , tomando en consideración los siguientes puntos:

 i ) Experimentalmente se encontró evidencia acerca de la forción de una solución sólida en el sistema Li<sub>2</sub>0 - Al<sub>2</sub>0<sub>3</sub> -SiO<sub>2</sub>, esto, en un amplio intervalo de composición, en la línea de unión Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub> - LiAlSiO<sub>4</sub>.

ii ) Tanto el Li $_4$ SiO $_4$  como el Li $_4$ GeO $_4$  presentan estructuras c<u>a</u>

paces de aceptar " impurezas " dentro de ellas [ 4 ]. iii) El Ge (IV) y Si (IV) guardan una estrecha relación entre sí.

En concreto, el trabajo experimental desarrollado para la elaboración de la presente tesis, tuvo como objetivos los siguientes puntos:

- a) Determinar el intervalo de composición en el que se lleva a cabo la formación de solución sólida en la línea de unión Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub> LiAlSiO<sub>4</sub>, en el sistema Li<sub>2</sub>O Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> SiO<sub>2</sub>.
- b) Determinar las propiedades eléctricas de cada una de las -preparaciones anteriores.
- c) Determinar los valores de Energía de activación para el pro ceso de conducción eléctrica en estos materiales.
- d) Determinar la posible existencia de una solución sólida en el sistema  $\text{Li}_20 - \text{Al}_20_3 - \text{GeO}_2$ , en particular, en la línea de unión  $\text{Li}_4\text{GeO}_4 - \text{LiAlGeO}_4$  y evaluar sus propiedades eléctricas en su caso.

# APITULO 2 С NO. EXPERIMENTAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

#### EXPERIMENTAL

2.1- REACTIVOS .-

Reactivo	Características	Temperatura	Tiempo d <b>e</b>	
ALERE FLA VERITAT		de secado	secado	
	2			
A1203	Cera, alta pureza	1000 °C -	6 horas	
Ge02	Grado electrónico	600 °C	6 ho <b>ras</b>	
Li2C03	ANALAR	160 °C	6 horas	
SiO <sub>2</sub>	Cristal de cuarzo	600 °C	6 horas	
UNIVERS	alta pureza	IA DE NUEV	O LEÓN	

#### DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Para cada uno de los reactivos señalados en la tabla ante--rior, se obtuvieron sus correspondientes patrones de difracción de rayos X, utilizando una cámara Philips Hagg - Guinier, con radiación Cu K<sub>A1</sub>; los patrones obtenidos fueron empleados como referencia.

2.2- MEZCLAS\_DE\_BEACCION.\_

Cada una de las mezclas de reacción fueron preparadas en can

tidades de aproximadamente 5 gramos, para lo cual se pesaron --las cantidades correspondientes de cada uno de los reactivos de acuerdo a la estequiometría deseada y se colocaron en un morte-ro de ágata en donde fueron molidos y homogeneizados, usando --acetona con el fin de ayudar a esto. Durante el proceso de mo---lienda, aproximadamente 20 minutos, el líquido orgánico se evapora gradualmente y después de 10 - 15 minutos se ha volatiliz<u>a</u> do totalmente.

Una vez secas las mezclas de reacción, se colocaron en recipientes de oro y fueron calentadas en muflas eléctricas, ini--cialmente a 650 °C por espacio de 4 horas, con el fin de expe-ler el dióxido de carbono proveniente de la descomposición del carbonato de litio. Concluída esta primera etapa, se incrementó paulatinamente la temperatura a 800, 900, 1000 y 1150 °C, mant<u>e</u> niendo las muestras en cada uno de estos valores por espacio de 12 - 15 horas, hasta completar la reacción. Al finalizar cada etapa de reacción se repetía la operación de molienda y se obtuvieron patrones de rayos X en polvos de cada una de las mues-tras, con el fin de observar si existía la formación de solu---ción sólida o no, y así contar con una evidencia de que que la reacción ha llegado al equilibrio.

#### 2.3\_ SINTERIZACION.-

Una vez caracterizadas las mezclas de reacción finales me--diante rayos X, se procedió a preparar las muestras en forma de

- 12 -

pastilla, para efectuar posteriormente mediciones de conductividad eléctrica. Con el objeto de hacer más fácilmente manejables las pastillas, fueron sometidas a un proceso de sinteriza ción, para lo cual fueron calentadas durante 8 horas a tempera turas entre 1100 y 1150 ° C.

#### 2.4 -MEDICION\_DE\_PROPIEDADES\_ELECTRICAS.-

Una vez sinterizadas las pastillas, les fueron colocados electrodos de oro sobre ambas caras. Para llevarlo a cabo, primeramente se cubrió uná de las caras de la pastilla con una pasta de oro y sobre ésta una pequeña laminilla rectangular, también de oro. Se colocó en una estufa eléctrica a una temperatura de 150 °C aproximadamente durante 30 minutos, después de lo cual se incrementó la temperatura a 500 °C por espacio de 1.5 - 2 horas. El proceder en dos etapas de calentamiento conlleva a que la capa superficial de oro sea homogénea y libre de burbujas de aire. Una vez fría la pastilla, se procedió de manera similar con la otra cara.

Ya instalado el par de electrodos se colocó la pastilla en la celda para medir su conductividad eléctrica a diferentes -temperaturas.

#### 2.5- TECNICAS .-

2-5.1. - <u>Difracción\_de\_rayos\_X</u>. Los diferentes productos fueron <u>identificados</u> mediante difracción de rayos X en polvos, emplean do una cámara Hagg - Guinier, radiación Cu K<sub>el</sub>. Con el fin de efectuar exactamente las mediciones de las --distancias interplanares, los compuestos puros se mezclaron -con KCl ( a = 6.2931 A ) como estándar interno y las películas obtenidas se midieron empleando un microdensímetro.

Las dimensiones de la celda unitaria se determinaron calculando los datos de distancia interplanar mediante el método de mínimos cuadrados. Para cada compuesto se utilizaron aproximadamente 10 - 20 líneas del patrón de difracción para el refinamiento.

2.5.2.- <u>Conductividad\_eléctrica</u>.Las mediciones de conductividad eléctrica se efectuaron empleando dos analizadores de impedan-cia de Respuesta - Frecuencia: Analizador de baja frecuencia marca Solartron, modelo 1250 y analizador de alta frecuencia marca Hewlett Packard.

Los sistemas de medición se encuentran totalmente controlados mediante una microcomputadora BBC, en la que pueden ser a<u>l</u> macenados los datos mediante discos magnéticos.

	Baja frecuencia	Alta frecuencia
Tiempo de integración	5 segundos	
Voltaje aplicado	0.1 Volts	0.1 Volts
Frecuencia máxima	65 x 10 <sup>3</sup> Hz	13 x 10 <sup>3</sup> KHz
Frecuencia minima	0,65 Hz	0.1 Hz
Resistencia	$1 \times 10^3$ Ohm	$1 \times 10^3$ Ohm

Las condiciones de operación fueron las siguientes:



## UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Se sintetizó una nueva fase,  $\text{Li}_{5}\text{AlSi}_{2}0_{8}$ , por reacción del es tado sólido en un intervalo de composición 0 < X < 0.60, en la - línea de unión  $\text{Li}_{4}\text{Si}0_{4}$  - LiAlSi $0_{4}$  del sistema  $\text{Li}_{2}0$  - Al $_{2}0_{3}$  - Si $0_{2}$ , figura no. 1.



Figura no. 1.- Intervalos de solución sólida en el sistema  $\text{Li}_20 - \text{Al}_20_3 - \text{SiO}_2$ . La serie no. 1 es la de interés en este trabajo.

El  $\text{Li}_4\text{SiO}_4$  existe en dos formas polimórficas que se encuentran separadas por un intervalo de temperatura entre 600 y 725 ° C, [ 14 ]. Se conoce la estructura cristalina de la forma de baja

temperatura, [ 15 ]: Posee una estructura cuya celda unitaria es monoclínica. Los átomos de oxígeno forman capas entrelazami das, mientras que los átomos de silicio se encuentran tetraédricamente coordinados al exígeno, siendo su estructura la de un ortosilicato típico con grupos  $(SiO_4)^{-4}$ aislados. La celda un<u>i</u> taria contiene 8 átomos de litio que se encuentran distribuídos entre un total de 18 sitios de coordinación 4, 5 y 6, por lo cual estos se encuentran solo parcialmente ocupados. Todo lo anterior contribuye a que el Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub> tenga una estructura anfitrión apropiada para aceptar otros iones o bien dar lugar a la formación de soluciones sólidas. Ambos polimorfos son ca paces de introducir otros cationes dentro de la estructura, me solamente reemplazando al silicio, sino también sustituyendo al litio, [ 16 ].

Los compuestos que se generan pueden considerarse como mat<u>e</u> riales procedentes del Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub> mediante la creación de huecos en su estructura, DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

 $3 \text{Li}^+ ---- A1^{+3} + 2 \text{ huecos},$ 

o bien como derivados del Li<sub>5</sub>AlSi<sub>2</sub>0<sub>8</sub> mediante la creación de 🖕 intersticios en su estructura,

$$Si^{+4}$$
 ----->  $A1^{+3}$  +  $Li^+$  intersticial, [4]

 sustitución,

$$3 \text{ A1}^{+3}$$
 ----  $2 \text{ Si}^{+4}$  + Li<sup>+</sup>

#### DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Los estudios sobre la línea  $\text{Li}_4\text{SiO}_4 - \text{Li}_5\text{AlSi}_2\text{O}_8$ , de acuerdo a lo mencionado en el párrafo precedente, mostraron que se forma una solución sólida completa con un cambio de simetr fa en valores intermedios de composición, desde la estructura monocl<u>í</u> nica del Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub> a la tetragonal del Li<sub>5</sub>AlSi<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. Esto queda de manifiesto en la figura no. 2, para la que se seleccionó la l<u>í</u> nea (0 2 <sup>3</sup>). La solución sólida que se formó puede escribirse co mo Li<sub>4-3X</sub>Al<sub>X</sub>SiO<sub>4</sub>, donde 0<X<0.60, o bien como Li<sub>5+3Y</sub>Al<sub>1-Y</sub>Si<sub>2</sub> O<sub>8</sub>, siendo -0.20<Y<1. En éstas fórmulas la composición del

TABLA NO. 1.- Datos de difracción de rayos X en po<u>l</u> vos para el  $\alpha$ - Li<sub>5</sub>AlSi<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. Tetragonal, a = 5.1062 (2) Å, c = 6.237 (3) Å; estándar interno: cuarzo.

	d <sub>obs</sub> (Å)	d <sub>calc</sub> (Å)	I	h	k	1	
2	ALERE FLAMMAM						
<u>S</u>		5.1066	5	0	1	0	
ER	3.9487	3.9533	100	0	1	1	
E	3.6148	3.6109	8	1	1	0	
E.	3.1165	3.1188	15	0	0	2	
	2.6633	2.6617	37	0	1	2	
TINI	2.5518	2.5533	33	0	2	0	
UNI	2.1465	2.1445		2		1 1	)IN R
	DIR <b>1.8407</b> [Ó]	N G <b>1.8426</b> AL	DE BIH	BLIO]	TE <b>Q</b> AS	2	li -
	1.8082	1.8055	1	2	2	0	
	1.8013	1.8018	3	1	1	3	
	1.5608	1.5625	7	2	2	2	
	1.4937	1.4941	9	0	3	2	ļ
	.1.3317	1.3308	5	0	2	4	
			1			and an a	1

$$Li_5AlSi_2O_8$$
 corresponde a X = 0.50, (Y = 0).



FIGURA NO. 2.- Gráfica de distancia interplanar contra composición.
La transición monoclínica - tetragonal es continua a medida que " X " cambia y se presenta a X =  $0.27 \pm 0.01$  ( Y = 0.46 ). Esta se manifiesta por un descenso gradual en el desdoblamientø de las líneas (1 3 2) y(0 2 3), características de la estructura del Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub>, a medida que " X " aumenta hasta un valor en el que este desdoblamiento ya no es detectable en la estructura t<u>e</u> tragonal, figura no. 3.



Figura no. 3.- Diagrama esquemático de líneas de difracción de rayos X.

No se encontró evidencia de una región bifásica que separe las fases monoclínica y tetragonal. Esto sugiere que la transición es estructuralmente continua.

Los resultados encontrados sobre la formación de una solu-ción sólida en un amplio intervalo de composición sobre la línea Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub> - LiAlSiO<sub>4</sub>, difiere de un informe anterior en donde el intervalo de solución sólida mucho más limitado, 04X<0.06 [11]. La diferencia es ocasionada por la variación en las condiciones de síntesis. Las temperaturas de reacción, en dicho -trabajo, se mantuvieron por debajo de 900 °C para evitar posi-bles pérdidas de Li<sub>2</sub>0 por volatilización. Bajo estas condicio-nes no se logró alcanzar un equilibrio termodinámico verdadero y solo se formó una solución sólida de intervalo limitado. En el presente trabajo se utilizaron mayores temperaturas de reacción, 1000 - 1100 °C, basados en la experiencia obtenida durante el estudio del sistema Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub> - LiGaSiO<sub>4</sub>, [ 18 ]. Como med<u>i</u> da de precaución, para minimizar la pérdida de Lig0 por volatilización, se elaboraron pastillas con las mezclas de reacción y cubiertas totalmente con muestra en polvo de la misma composi-ción. Una vez formada la solución sólida, resultó termodinámicamente estable aún a temperaturas cercanas a su punto de fusión, aproximadamente 1100 - 1150 °C.

## 3.2. CONDUCTIVIDAD ELECTRICA . -

Se efectuaron mediciones de conductividad eléctrica en muestras de diversas composiciones de la solución sólida repre sentada por la fórmula Li4-3xAlxSiO4, en un intervalo de tempe ratura de 40 °C a 273 °C aproximadamente. Estas mediciones, co mo se indica en la parte experimental, se realizaron mediante la técnica de Espectroscopía de Impedancia de corriente alterna, para la cual se utilizaron dos instrumentos denominados Analizadores de Impedancia. Estos permitieron medir simultáneamente los valores de las partes real e imaginaria de la impe-dancia compleja y del módulo complejo, así como los valores co rrespondientes de capacitancia. La información obtenida se interpretó gráficamente mediante Planos de Impedancia Compleja y Curvas Espectroscópicas. Los planos de impedancia compleja se elaboraron graficando el valor de la parte imaginaria ( Z" ) contra el valor de la parte real ( Z' ) de la impedancia com-pleja ( Z<sup>\*</sup> ). En las figuras no. 4 y no. 5 se muestran en forma general los dos tipos de gráficas encontradas en este siste ma.

El primer tipo de plano de impedancia compleja está -constituído por un solo semicírculo cuya intersección con el éje Z' representa la resistividad de cada muestra, R<sub>bulk</sub>. El s<u>e</u> gundo tipo de plano de impedancia compleja está formado por 2 semicírculos cuyas intersecciones con el eje Z' proporcionan - la resistividad del bulto cerámico, R<sub>bulk</sub>, y la resistividad de la frontera de grano, R<sub>eb</sub>.

En muchas ocasiones es difícil darse cuenta, tan solo con los planos de impedancia compleja, si realmente se trata de dos semicírculos o bien de uno solo pero distorsionado. Para aclarar esto, es sumamente útil recurrir a las denominadas curvas espectroscópicas, elaboradas graficando la parte imaginaria de la impedancia compleja ( 2" ) y/o del módulo complejo ( M" ) contra el logaritmo de la frecuencia ( f ). Está demostrado teórica y experimentalmente que un semicírculo en el pla no de impedancia compleja corresponderá a un pico de Debye en éstas curvas [ 6, 19 ]. En las figuras no. 6 y no. 7 se mues-tran las formas típicas de dichas curvas que se encontraron en este sistema a dos valores diferentes de composición y tempera tura. En la primera figura se aprecia claramente un solo pico, lo que nos lleva a afirmar que se tiene un solo semicírculo; en cambio, en la figura no. 7 se aprecian dos valores máximos, -aunque no totalmente resueltos, lo cual permite afirmar que se tiene la presencia de dos semicírculos.

A continuación se describen detalladamente los result<u>a</u> dos obtenidos de la medición de la conductividad eléctrica para cada una de las muestras sintetizadas y sinterizadas, así como la relación de estos datos con la temperatura y la composición. 3.2.1- PLANOS DE IMPEDANCIA COMPLEJA.

En las figuras no. 8 a la no. 22 se muestran las curvas experimentales típicas de impedancia compleja para cada una de las diferentes composiciones estudiadas, a dos valores difere<u>n</u> tes de temperatura.

Los resultados de la impedancia de corriente alterna mostraron variación de una muestra a otra, tanto en magnitud como en el número de semicírculos que aparecen en las gráficas de plano de impedancia compleja. La mayoría de las muestras, con valores de composición 0.15, 0.20, 0.2625, 0.275, 0.325, -0.35, 0.50, 0.55 y 0.60, presentaron planos de impedancia compleja con una región de alta frecuencia constituída por un solo arco cuya intersección con el eje Z' proporciona la resisti vidad de cada muestra, como se indica en la figura no. 4. Así mismo se aprecia una región de baja frecuencia constituída por una línea recta que está asociada con la polarización de la in terfase electrodo - electrólito. Los valores de capacitancia a sociados a cada una de las muestras oscilaron entre 1.5 y 17 pF. Además, se encontró un máximo en las gráficas de la parte imaginaria del módulo complejo ( M" ) contra el logaritmo de la frecuencia de cada una de las muestras, por lo que pudimos afirmar que se cuenta tan solo con la presencia de un semicirculo que es atribuído a la respuesta intragranular de las mues tras.

En los planos de impedancia compleja para las muestras restantes, de composición 0.10, 0.225, 0.25, 0.30, 0.40 y 0.45, se aprecian también dos regiones: una de alta frecuencia, que de acuerdo a las gráficas de M" contra el logaritmo de la frecuencia, está formada por dos semicírculos; y una segunda re-gión de baja frecuencia constituída por una línea recta que, de nueva cuenta, está asociada con la polarización de la inte<u>r</u> fase electrodo - electrólito.

Como se mencionó en el párrafo anterior, dentro de la región de alta frecuencia se hallan dos semicírculos distorsion nados, los cuales no pudieron ser resueltos con exactitud. El semicírculo localizado a mayores valores de frecuencia, está relacionado con la resistencia intragranular o respuesta del - cuerpo cerámico del electrólito sólido. En la figura no. 5 se muestra el caso hipotético en el que fuese posible la total resolución de los semicírculos. El intercepto,  $R_{bulk}$ , con el eje Z', representa la resistividad de los granos del material. El semicírculo localizado a menores valores de frecuencia se atribuye a la impedancia de la frontera intergranular, en serie -- con la impedancia intragranular. La intersección,  $R_{gb}$ , con el eje Z', en la figura no. 5, representa la resistividad de la - frontera de grano.

En las figuras no. 8b a la no. 22b, se aprecia la res-

puesta electrodo - electrólito a mayores temperaturas. Estas tienden a adoptar la forma de una línea recta, cuyo comporta-miento es típico para una doble capa de bloqueo y representa una confirmación de que la especie móvil es un ión [ 13 ]; en particular, la especie móvil debe ser el ión litio.

3.2.2- DEPENDENCIA DE LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CON LA TEMPERATU

RA.

A partir de los planos de impedancia compleja se dete<u>r</u> minaron los valores de resistividad de cada muestra para los diferentes valores de composición y temperatura. Con estos datos fue posible calcular los valores correspondientes de con-ductividad, teniendo en cuenta que ésta no es más que el inve<u>r</u> so de la resistividad. En las tablas no. 2 a la no. 16 apare-cen las magnitudes de la conductividad eléctrica en cada caso.

La manera más adecuada para observar la influencia de la variable temperatura sobre la conductividad eléctrica, es con las gráficas de Arrhenius, en la que se grafica el logari<u>t</u> mo de la conductividad contra el inverso de la temperatura,-- wer figura no. 23, que fue elaborada para un intervalo de tem peratura de 50 a 273 <sup>O</sup>C aproximadamente y en la que aparece tam bién la información correspondiente para el  $\text{Li}_4\text{SiO}_4$  ( composi--ción X = 0 ) para fines de comparación. De esta gráfica pueden mencionarse algunos aspectos interesantes:

- a) Claramente se aprecia que independientemente del valor de composición, la temperatura ejerce la misma influencia sobre la conductividad eléctrica del material: a medida que la tem peratura aumente, la conductividad se incrementa también, pero de manera exponencial.
- b) Puede afirmarse que todas las líneas que aparecen en la figu ra son aproximadamente paralelas, es decir, que para una diferencia dada de temperatura, se obtendrá el mismo cambio de Conductividad eléctrica, independientemente de la composi--ción.
  - c) Planteado de manera general: La relación conductividad eléctrica - temperatura obedece a un mismo patrón, tanto de man<u>e</u> ra cualitativa como cuantitativa y ese patrón común de cada una de las líneas de composición constante, lo constituye el mecanismo de conducción eléctrica que es de esperarse sea el mismo, en todo el intervalo de temperatura estudiado.

Con el objeto de obtener mayor evidencia acerca de si -

realmente el mecanismo causante del fenómeno es el mismo en el intervalo de temperatura y composición estudiados, fue necesa-rio evaluar la energía de activación de dicho proceso. Para hacerlo, se parte de que éste es un fenómeno activado térmicamente cuyo modelo matemático se conoce como ecuación de Arrhenius y establece que

 $\sigma * T = A * EXP (-E_{act} / R * T)$ 

donde  $\sigma$  = Conductividad eléctrica, T = Temperatura absoluta, A = Factor frecuencia o pre- exponencial,  $E_{act}$  = Energía de activación. R = Constante universal de los gases.

De acuerdo a este modelo, se representó gráficamente el logarit mo del producto de la conductividad y la temperatura contra el valor 1000 / T, como se aprecia en la figura no. 24, obteniéndo se como pendiente el valor de  $(-E_{act} / R)$  y como ordenada al origen, el factor pre - exponencial o factor frecuencia. Las --magnitudes encontradas de estos parámetros aparecen en la tabla no. 17. De acuerdo a ésta, los valores de la energía de activación oscilan dentro de un intervalo relativamente pequeño, de -0.51 a 1.23 eV, lo que de nuevo nos lleva a sospechar que, efec tivamente el mecanismo mediante el cual se realiza el fenómeno de la conducción eléctrica en este material es muy similar en todo el intervalo de temperatura y composición estudiados. 3.2.3\_ DEPENDENCIA DE LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CON LA COMPOSICION

Si se analiza nuevamente la figura no. 23, puede observarse que la línea recta de referencia, correspondiente a ---Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub> ( composición X = 0 ), define claramente dos zonas que serán denominadas: región superior y región inferior.

a) Región superior.- Para una temperatura dada, todas las muestras cuya composición está en el intervalo 0.10 - 0.45 poseen una conductividad eléctrica mayor que el Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub>; ¿ Cuánto más ? Para el valor particular de composición X = 0.10, la conductiv<u>i</u> dad es aproximadamente el doble ( 100 % mayor ), en cambio, para cuando la composición alcanza un valor de X = 0.25, la con-ductividad llega a ser 800 veces mayor que la de referencia ---( ¿ 799 900 mayor ! ). Para los valores intermedios de composición sus conductividades correspondientes se hallan dentro de los límites anteriores.

b) Región inferior.- Para una temperatura dada, las muestras c<u>u</u> yos valores de composición se encuentran en el intervalo de 0.5 a 0.60, poseen una conductividad eléctrica menor que el  $\text{Li}_4\text{SiO}_4$ ; esta diferencia oscila desde 4 x 10<sup>-3</sup> veces la de referencia -( la conductividad del  $\text{Li}_4\text{SiO}_4$  es mayor en un 24 900 % que la de la muestra X = 0.60 ), hasta 8 x 10<sup>-4</sup> veces la misma ( la -conductividad de referencia es mayor en un 124 900 % ) para cua<u>n</u> do X = 0.50 . De inmediato salta a la vista que el valor de la comp<u>o</u> sición tiene una influencia determinante en la magnitud de la conductividad eléctrica del material. En la figura no. 25 se muestra la variación de la conductividad respecto a la compos<u>i</u> ción particular de cada muestra para ciertos valores específicos de temperatura.

La conductividad del Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub> es baja, del orden de  $10^{-8}$ Ohm<sup>-1</sup> cm<sup>-1</sup> a 110 °C [ 12 ].La conductividad del Li<sub>5</sub>AlSi<sub>2</sub>O<sub>8</sub> ---( X = 0.50 para la fórmula Li<sub>4-3X</sub>Al<sub>X</sub>SiO<sub>4</sub> ) es aún menor, alrededor de 10 <sup>-13</sup> Ohm<sup>-1</sup> cm<sup>-1</sup> a 100°C. Para valores intermedios de composición, la conductividad se incrementa drásticamente y alcanza un valor máximo de aproximadamente 2 x  $10^{-6}$ Ohm<sup>-1</sup> cm<sup>-1</sup> a 100 °C o bien 1 x 10 <sup>-3</sup> Ohm<sup>-1</sup> cm<sup>-1</sup> a 300 °C.

## UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

La conductividad vuelve a aumentar con valores de composición X = 0.50, aunque solamente se obtuvieron unos cuantos datos para estas magnitudes de composición.





Figura no. 6 .- Curva espectroscópica correspondiente a la solución sólida de fórmula  $\text{Li}_{4-3X}\text{Al}_X\text{SiO}_4$ , siendo X = 0.60 (temp. 224 ° C).



Figura no. 7 .- Curva espectroscópica correspondiente a la solución sólida de fórmula  $Li_{4-3X}Al_XSiO_4$ , siendo X = 0.10 (temp. 100 <sup>O</sup>C).



Figura no. 8.- Planos de impedancia compleja para la solución sólida  $Li_{4-3X}Al_{X}Si0_{4}$ , siendo X = 0.10 .



Figura no. 9.- Planos de impedancia compleja para la solución sólida  $Li_{4-3X}Al_XSiO_4$ , siendo X = 0.15



Figura no. 10.- Planos de impedancia compleja para la solución sólida  $Li_{4-3X}Al_XSiO_4$ , siendo X = 0.20.



Figura no. 11.- Planos de impedancia compleja para la solución sólida  $Li_{4-3X}Al_XSiO_4$ , siendo X = 0.225 .



Figura no. 12.- Planos de impedancia compleja para la solución sólida  $$^{\rm Li}$_{4-3X}{}^{\rm Al}$_X{}^{\rm Si0}$_4, siendo X = 0.25$  .



Figura no. 13.- Planos de impedancia compleja para la solución sólida  $Li_{4-3x}Al_xSiO_4$ , siendo X = 0.2625 .



Figura no. 14.- Planos de impedancia compleja para la solución sólida  $Li_{4-3X}Al_XSiO_4$ , siendo X = 0.275 .



Figura no. 15.- Planos de impedancia compleja para la solución sólida  $Li_{4-3X}Al_XSiO_4$ , siendo X = 0.30 .



Figura no. 16.- Planos de impedancia compleja para la solución sólida  $Li_{4-3X}Al_XSiO_4$ , siendo X = 0.325 .



Figura no. 17.- Planos de impedancia compleja para la solución sólida  $Li_{4-3X}A1_XSiO_4$ , siendo X = 0.35



Figura no. 18.- Planos de impedancia compleja para la solución sólida  $Li_{4-3X}Al_XSiO_4$ , siendo X = 0.40 .



Figura no. 19.- Planos de impedancia compleja para la solución sólida  $Li_{4-3x}Al_xSiO_4$ , siendo X = 0.45 .



Figura no. 20.- Planos de impedancia compleja para la solución sólida  $Li_{4-3X}Al_XSiO_4$ , siendo X = 0.50 .



Figura no. 21.- Planos de impedancia compleja para la solución sólida ${\rm Li}_{4-3X}{\rm Al}_X{\rm SiO}_4,\; {\rm siendo}\; X\,=\,0.55~.$ 



Z', Ohm cm

Figura no. 22.- Planos de impedancia compleja para la solución sólida  $Li_{4-3X}Al_XSiO_4$ , siendo X = 0.60 .



Figura no. 23.- Gráficas de conductividad de Arrhenius para la solución sólida de fórmula Li<sub>4-3X</sub>Al<sub>X</sub>SiO<sub>4</sub>.



Figura no. 24.- Gráficas de Arrhenius de conductividad para la solución sólida de fórmula  $Li_{4-3X}Al_XSiO_4$ .



COMPOSICION ( X )

Figura no. 25.- Dependencia de la conductividad eléctrica con la composición para la solución sólida con — fórmula  $Li_{4-3X}Al_XSiO_4$ .





## TABLA NO. 3.- RESULTADOS DE CONDUCTIVIDAD PARA EL $Li_{4-3X}Al_XSiO_4$ , SIENDO X = 0.15





TABLA NO. 5.- RESULTADOS DE CONDUCTIVIDAD PARA EL  $\text{Li}_{4-3X}\text{Al}_X\text{SiO}_4$ , SIENDO X = 0.225


TABLANO. 6 .- RESULTADOS DE CONDUCTIVIDAD PARA



# TABLA NO. 7.- RESULTADOS DE CONDUCTIVIDAD PARA EL $\text{Li}_{4-3X}\text{Al}_X\text{SiO}_4$ , SIENDO X = 0.2625





TABLA NO. 9.- RESULTADOS DE CONDUCTIVIDAD PARA EL  $\text{Li}_{4-3X}\text{Al}_{X}\text{SiO}_{4}$ , SIENDO X = 0.30



TABLA NO. 10.-RESULTADOS DE CONDUCTIVIDAD PARA EL



## TABLA NO. 12.- RESULTADOS DE CONDUCTIVIDÃO PARA EL $\text{Li}_{4-3X}\text{Al}_X\text{SiO}_4$ , SIENDO X = 0.40





- 65 -



## DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

. r.



TABLA NO. 15.- RESULTADOS DE CONDUCTIVIDAD PARA EL Li<sub>4-3X</sub>Al<sub>x</sub>SiO<sub>4</sub>, SIENDO X= 0.55



.

### TABLA NO. 17 a-PARAMETROS DE LA ECUACION DE ARRHENIUS

	COMPOSICION	ENERGIA DE ACTIVACION	LOG A	
94	(X)	(eV)		
15	0.10	0.71	4.59	
TON	0.15	0.67	2.6	
TALEDE E	0.20	0.61	5.79	1/
VERITA	0.225	0.56	5.21	
IN I	0.25	0.66	6,51	
	0.2625	0.61	5.75	
	0.275	0.51	4.46	
	0.30	0.61	5.49	
	0.325	0.55	4.98	
UNIVER.	SIDA <sub>0.35</sub> AU	TONO <sub>0.63</sub> de nu	EV4.9 LE	ON
DIRE	CCIO <sup>9,40</sup> GEN	VERAL <sup>0.64</sup> BIBLIO	TECAS	
	0.45	0.70	4,93	
	0.50	1.23	6 <b>.76</b>	
	0.55	1.00	4.77	
	0.60	0.87 -	4.18	

٤.,



## UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN () DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Se sintetizó una nueva fase por reacción del **estado aj** lido en un intervalo de composición  $0 < X \le 0.50$ , en la línea de umión Li<sub>4</sub>GeO<sub>4</sub> - LiAlGeO<sub>4</sub> del sistema Li<sub>2</sub>O - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - GeO<sub>2</sub>, fig<u>u</u> ra no. 26.



diado en el sistema  $Li_2O - Al_2O_3 - GeO_2$ .

El Li<sub>4</sub>GeO<sub>4</sub> existe en dos formas polimórficas. El pol<u>i</u> morfo de baja temperatura es diferente de la forma de baja -temperatura del Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub>. En aquella, los iones litio poseen totalmente una coordinación de 4 y todos los sitios de iones litio se encuentran totalmente ocupados. Una comparación de los dos tipos de estructura muestra que los tetraedros (GeO<sub>4</sub>) se hallan girados unos pocos grados respecto a los tetraedros ( $SiO_4$ ). Esto provoca un cambio en la forma, tamaño y disponi bilidad de los sitios para los iones litio, [7]. Por tanto, es de esperar que, al igual que el Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub>, el Li<sub>4</sub>GeO<sub>4</sub> tenga una estructura capaz de aceptar otros iones o bien dar lugar a la formación de soluciones sólidas.

Los compuestos que se generan pueden considerarse como materiales procedentes del Li<sub>4</sub>GeO<sub>4</sub> mediante la creación de hu<u>e</u> cos en su estructura,

 $3 \text{ Li}^+ - - - + \text{ Al}^{+3} + 2 \text{ huecos},$ 

o bien como derivados del Li<sub>5</sub>AlGe<sub>2</sub>O<sub>8</sub> mediante la creación de intersticios en su estructura,

## UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Ge<sup>+4</sup> ----> Al<sup>+3</sup> + Li<sup>+</sup> intersticial, DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Los estudios sobre la línea  $\text{Li}_4\text{GeO}_4 - \text{Li}_5\text{AlGe}_2\text{O}_8$  mos-traron que se forma una solución sólida completa con un cambio de simetría en valores intermedios de composición, desde la e<u>s</u> tructura monoclínica del  $\text{Li}_4\text{GeO}_4$  a la tetragonal del  $\text{Li}_5\text{AlGe}_2\text{O}_8$ . La solución sólida que se formó puede escribirse mediante la fórmula  $\text{Li}_{4-3X}\text{Al}_X\text{GeO}_4$ , donde  $0 \le X \le 0.50$ . En estas fórmulas la composición del  $\text{Li}_5\text{AlGe}_2\text{O}_8$  corresponde a X = 0.50.

La transición monoclínica - tetragonal es continua a -

medida que " X " cambia y se presenta a X = 0.15  $\stackrel{+}{=}$  0.01. No se encontró evidencia de una región bifásica que separe las fases monoclínica y tetragonal. Esto sugiere que la transición es es tructuralmente continua.



## UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

#### 4.2-CONDUCTIVIDAD ELECTRICA . --

Se efectuaron mediciones de conductividad eléctrica en muestras de diversas composiciones de la solución sólida repre sentada por la fórmula  $Li_{4-3x}Al_xGeO_4$ , en un intervalo de tempe ratura de - 20 ° C a 350 ° C aproximadamente. Estas mediciones mencionadas en la parte experimental, se efectuaron mediante la técnica de Espectroscopía de Impedancia de corriente alterna, para la cual se utilizaron dos instrumentos denominados Analizadores de Impedancia. Estos permitieron medir simultáneamente los valores de las partes real e imaginaria de la impe-dancia compleja y del módulo complejo así como los valores correspondientes de capacitancia. La información obtenida se in terpretó gráficamente mediante planos de impedancia compleja y curvas espectroscópicas. Los planos de impedancia compleja se elaboraron graficando el valor de la parte imaginaria ( Z " ) contra el valor de la parte real ( Z ' ) de la impedancia compleja ( Z \* ). En la figura no. 5 se muestra en forma general el tipo de gráfica encontrado en este sistema. La información obtenida de ella se explicó en la sección de resultados de con ductividad eléctrica del sistema Li20 - Al203 - SiO2 ( capítulo pre cedente ).

En el caso del sistema conteniendo Ge, se obtuvieron básicamente los mismos tipos de curvas espectroscópicas que en el

74 -

sistema  $\text{Li}_20 - \text{Al}_20_3 - \text{Si}_20_2$ , figuras no. 6 y no. 7.

A continuación se describen detalladamente los resulta dos obtenidos de la medición de la conductividad eléctrica para cada una de las muestras sintetizadas y sinterizadas, así como la relación de estos datos con la temperatura y la composición.

4.2.1\_ PLANOS DE IMPEDANCIA COMPLEJA.

En las figuras no. 28 a la no. 32 se muestran las curvas experimentales típicas de impedancia compleja para algunos valores de composición estudiados, a dos temperaturas diferen-

## UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Los resultados de la impedancia de la corriente alterna mostraron variación de una muestra a otra. Si bien todos -los planos de impedancia compleja se hallan caracterizados por la presencia de una región de alta frecuencia constituída por dos semicírculos, es importante observar lo siguiente:

a) Para valores de composición comprendidos entre X = 0.10 y X = 0.175, a temperaturas menores de 40 ° C, solamente apa
rece bien definido un semicírculo localizado a la izquierda

cia compleja (Z \*) es posible a valores bajos de frecuencia, observar la aparición de la línea recta asociada con la polarización de la interfase electrodo - electrólito.

### 4.2.2- DEPENDENCIA DE LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CON LA TEMPERATU

RA. ONOA

A partir de los planos de impedancia compleja se deter minaron los valores de resistividad asociada al bulto cerámico de cada muestra para los diferentes valores de composición y temperatura. Con estos datos fue posible calcular los valores correspondientes de conductividad eléctrica del cuerpo cerámico ( $\sigma$  bulk), teniendo en cuenta que ésta no es más que el in verso de la resistividad. En las tablas no. 17 a la no. 30 apa recen las magnitudes de la conductividad eléctrica en cada caso.

La manera más adecuada para observar la influencia que la variable temperatura posee sobre la conductividad eléctrica de un material, es con las gráficas de Arrhenius, en las que se gráfica el logaritmo de la conductividad eléctrica contra el inverso de la temperatura, como puede apreciarse en la figura no. 33, que fue elaborada para un intervalo de temperatura de - 20 °C a 350 °C aproximadamente y en la que apara ce también la información correspondiente para el Li<sub>h</sub>GeO<sub>h</sub> - ( composición X = 0 ) para fines de comparación. De esta gráfi ca pueden mencionarse algunos aspectos interesantes:

- a) Claramente se aprecia que independientemente del valor de composición, la temperatura ejerce la misma influencia sobre la conductividad eléctrica del material: a medida que la tem peratura aumenta, la conductividad se incrementa también, pe ro de manera exponencial.
- b) Puede afirmarse que todas las líneas que aparecen en la figura son aproximadamente paralelas, es decir, que para una dife-rencia dada de temperatura, se obtendrá el mismo cambio de conductividad eléctrica, independientemente de la composi--ción.
- c) Planteado de manera general: La relación conductividad eléctrica - temperatura obedece a un mismo patrón, tanto de mang ra cualitativa como cuantitativa y ese patrón común de cada una de las líneas de composición constante, lo constituye el mecanismo de conducción eléctrica que es de esperarse sea el mismo, en todo el intervalo de temperatura estudiado.

Con el objeto de obtener mayor evidencia acerca de si realmente el mecanismo causante del fenómeno es el mismo en el intervalo de temperatura y composición estudiados, fue necesa-rio evaluar la energía de activación de dicho proceso. Para hacerlo, al igual que en el capítulo precedente, se parte de que es un fenómeno activado térmicamente y se hace uso, de nueva -cuenta de la Ecuación de Arrhenius. De acuerdo a este modelo, se representó gráficamente el logaritmo del producto de la conductividad eléctrica del cuerpo cerámico y la temperatura contra el valor 1000/T, como se aprecia en la figura no. 34, obteniéndose como pendiente el valor de  $(-E_{act}/R)$  y como ordenada al  $e_{-}$ rigen, el logaritmo natural del factor pre - exponencial o factor frecuencia. Las magnitudes encontradas de éstos parámetros aparecen en la tabla no. 31. De acuerdo a ésta, los valores de energía de activación oscilan dentro de un intervalo relativa-mente pequeño, de 0.37 a 1.28 eV, lo que de nuevo nos lleva a sospechar que, efectivamente el mecanismo mediante el cual se realiza el fenómeno de la conducción eléctrica en este material es muy similar en todo el intervalo de temperatura y composi--ción estudiado DAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

#### 4.2.3- DEPENDENCIA DE LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CON LA COMPOSICION

Si se analiza nuevamente la figura no. 33, puede observarse que la línea recta de referencia, correspondiente al germanato de litio ( composición X = 0 ), define claramente dos zo nas que serán denominadas: región superior y región inferior.

a) Región superior .- Para una temperatura dada, todas las mues-

tras cuya composición está en el intervalo 0.10 - 0.45 po---seen una conductividad eléctrica mayor que el Li<sub>4</sub>GeO<sub>4</sub>. Para el valor particular de composición X = 0.45, la conductividad es 102 veces mayor ( 10109 % mayor ), en cambio, para --cuando la composición alcanza un valor de X = 0.10, la conduç tividad llega a ser 242930 veces mayor que la de referencia ( 2.429 x  $10^7$  % mayor ). Para los valores intermedios de com posición sus conductividades correspondientes se hallan dentro de los límites anteriores.

b) Región inferior.- Para una temperatura dada, la muestra con un valor de composición X = 0.50 posee una conductividad e-léctrica menor que el  $\text{Li}_4\text{GeO}_4$ , 4 x  $10^{-4}$  veces la de referencía ( la conductividad del compuesto de referencia es mayor en un 247950 % que la de la muestra X = 0.50 ).

### UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN

De inmediato salta a la vista que el valor de la composición tiene una influencia determinante en la magnitud de la conductividad eléctrica del material. En la figura no. 35 se --muestra la variación de la conductividad respecto a la composición particular de cada muestra para ciertos valores específi--cos de temperatura.

La conductividad del Li<sub>4</sub>GeO<sub>4</sub> es muy baja, del orden de 1 x 10<sup>-10</sup> Ohm<sup>-1</sup>cm<sup>-1</sup> a una temperatura de 111 ° C [ 20 ]. La con ductividad del Li<sub>5</sub>AlGe<sub>2</sub>O<sub>8</sub> ( X = 0.50 para la fórmula Li<sub>4-3X</sub>Al<sub>X</sub>\*  $GeO_4$  ) es aún menor, alrededor de  $10^{-13}$   $Ohm^{-1}cm^{-1}$  a 100 ° C. P<u>a</u> ra valores intermedios de composición, la conductividad se in-crementa drásticamente y alcanza un valor máximo de aproximadamente 3.8 x  $10^{-4}$   $Ohm^{-1}$  cm<sup>-1</sup> a 100 ° C o bien 9 x  $10^{-2}Ohm^{-1}$  cm<sup>-1</sup> a una temperatura de 300 ° C.



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



Figura no. 28 -- Planos de Impedancia Compleja para la solución sólida  $L_4^{-3X}A_{X}^{A}C_{4}^{GeO}$ , siendo X = 0.10.







Figura no. 30 .- Planos de Impedancia Compleja para la solución sólida  $Li_{4-3X}Al_XGeO_4$ , siendo X = 0.30 .







Figura no. 32 .- Planos de Impedancia Compleja para la solución sólida  $Li_{4-3X}Al_XGeO_4$ , siendo X = 0.50 .











TABLA NO. 17 D-RESULTADOS DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA DEL CUERPO CERAMICO DEL  $Li_{4-3X}Al_XGeO_4$ SIENDO X = 0.10



- 90 -







A NO. 20.- RESULTADOS DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA  
DEL CUERPO CERAMICO DEL 
$$\text{Li}_{4-3X}\text{Al}_{X}\text{GeO}_{4}$$
  
SIENDO X = 0.175

\*

- 93 -








SIENDO X = 0.30TEMPERATURA CONDUCTIVIDAD  $(Ohm^{-1} cm^{-1})$ (°C) 3.78 x 10<sup>-8</sup> 25  $1.24 \times 10^{-7}$ 40  $2.94 \times 10^{-7}$ 50 **UNIVERSI** LEÓ  $4.84 \times 10^{-7}$ 62 DIRECCIÓN GENE **AS** 8.35 x 10<sup>-7</sup>  $2.05 \times 10^{-6}$ 100

TABLA NO. 25.- RESULTADOS DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA DEL CUERPO CERAMICO DEL  $\text{Li}_{4-3X}\text{Al}_X\text{GeO}_4$ SIENDO X = 0.30

4



TABLA NO. 26.- RESULTADOS DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA DEL CUERPO CERAMICO DEL LI4-3XA1XGeO4

<u>م</u>



TABLA NO. 27.- RESULTADOS DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA

- 100 -



TABLA NO. 28.- RESULTADOS DE CONDUCTIVIDAD ELECIRICA





## TABLA NO. 31.- PARAMETROS DE LA ECUACION DE ARRHENIUS

f	COMPOSICION	ENERGIA DE ACTIVACION	LOG A	
	(X)	(eV)		
	0.10	0.42	4.58	
ATO	0.125	0.37	4.04	
ALERIVE	FLAMMAM RITATIS 0.15	0.44	5.06	
ISSI	0.175	0.56	6.60	
E Z	0.20	-0.39	4.28	r
E	0.225	0.45	4.55	
	0.25	0.53	5.56	
	0.275	0.61	5.32	
UNIVE	RSID0430 AU	TÓNOR54 DE NU	E 4.22 I	EÓN
DIR	0.325 ECCION GE 0.35	0.55 NERAL DE BIBLIO 0.77	4.98 TECAS 6.85	R
	0.40	0.83	6.58	
	0.45	0.80	6.04	
	0.50	1.28	6.66	

3

## CAPITULO NO. 5

RELACION DE RESULTADOS DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA DE LAS SOLU-CIONES SOLIDAS DE FORMULAS LI<sub>4-3X</sub>A1<sub>x</sub>SiO<sub>4</sub> y Li<sub>4-3X</sub>A1<sub>x</sub>GeO<sub>4</sub>. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN R DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS RELACION DE RESULTADOS DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA. -

Como se muestra en la figura no. 36, la solución sólida de fórmula  $\text{Li}_{4-3X}\text{Al}_{x}\text{GeO}_{4}$  presenta valores de conductividad elég trica mayores que los encontrados para el  $\text{Li}_{4-3X}\text{Al}_{x}\text{SiO}_{4}$  y que los reportados para el  $\text{Li}_{4-3X}\text{Ga}_{x}\text{SiO}_{4}$ , [ 12 ], llegándose a al-canzar una diferencia, respecto a ésta última, de un orden de magnitud. Todas las isotermas que muestran la dependencia de la conductividad eléctrica con la composición, de cada una de las soluciones sólidas mencionadas, presentan un comportamiento tipo " domo ", cuyos valores máximos difieren tanto en magnitud como en el valor de composición en el que se localizan.

El comportamiento de estos sistemas puede explicarse en términos de la Teoría de la Conducción al Azar (Random Walk --Theory ), empleando la ecuación MA DE NUEVO LEÓN R DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS T = A exp ( - E / k T )

=  $N(ze)^2 a^2 k^{-1} c(1-c) w_{o} exp(\Delta S/k) exp(-E/kT)$ 

donde N = Número de sitios equivalentes para los iones móviles
dentro de la estructura,

c = Fracción de sitios ocupados, es decir, la concentra-ción de iones en esos sitios,



Figura no. 36 .- Isotermas de conductividad eléctrica para las soluciones sólidas de fórmula  $\text{Li}_{4-3x}\text{Al}_x\text{GeO}_4$ ,  $\text{Li}_{4-3x}\text{Al}_x\text{SiO}_4$ , y -  $\text{Li}_{4-3x}\text{Ga}_x\text{SiO}_4$ .

- ze Carga de los iones móviles,
  - a = Distancia de " salto " para los iones,
- w<sub>o</sub> = Frecuencia vibracional fundamental de los iones móviles,
- Factor geométrico que depende del número de "saltos" posibles de un ión móvil ( con frecuencia presenta va lores de 1/2 o 1/3 ),
- k = Constante de Boltzmann,
- AS = Cambio entrópico de activación del proceso de conducción.
  - E = Energía de activación,
  - T = Temperatura absoluta.

En aquellos valores en los que se presentan los valores máximos de conductividad eléctrica, el grado de ocupación ( c ) o fracción de sitios ocupados por iones móviles se optimiza, idealmente, cuando c = 0.50 ( X = 0.25 aproximadamente ). La expresión para el factor pre - exponencial contiene al término -c ( 1 - c ), que tiene un valor máximo a c = 0.50, [ 12 ]. A mg dida que " c " se aproxima a la unidad (  $\text{Li}_4\text{SiO}_4$  y  $\text{Li}_4\text{GeO}_4$  ) o bien a cero (  $\text{Li}_5\text{AlSi}_2\text{O}_8$  y  $\text{Li}_5\text{AlGe}_2\text{O}_8$  respectivamente ), el té<u>r</u> mino c ( 1 - c ) adquiere valores muy pequeños y esto se ve reflejado en los bajos valores de conductividad eléctrica de di-chos materiales esteqiométricos. Ahora bien, a medida que el v<u>a</u> lor de " c " tiende a 0.50, la conductividad se verá incrementa da, dando lugar a una gráfica de conductividad contra composi--ción con una forma similar a las obtenidas.



## UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CONCLUSIONES .-

Los aspectos de cristaloquímica y conductividad eléctrica, en las uniones  $\text{Li}_4\text{SiO}_4$  -  $\text{LiAlSiO}_4$  y  $\text{Li}_4\text{GeO}_4$  -  $\text{LiAlGeO}_4$ son semejantes, cualitativamente hablando. En el aspecto cuan titativo muestran diferencias, tanto en la magnitud de la con ductividad eléctrica como en el valor de composición para el que se presenta un máximo en dicha conductividad. Estas diferencias son por sí solas interesantes, más aún si son compara das con la información que se tiene acerca de la línea de --unión  $\text{Li}_4\text{SiO}_4$  -  $\text{LiGaSiO}_4$ .

Las soluciones sólidas intersticiales de fórmulas ---Li<sub>4-3X</sub>Al<sub>X</sub>SiO<sub>4</sub> y Li<sub>4-3X</sub>Al<sub>X</sub>GeO<sub>4</sub> poseen una estructura estrechamente relacionada con la del 8- LiAlO<sub>2</sub>, siendo monoclínica la estructura de los compuestos de partida: Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub> y Li<sub>4</sub>GeO<sub>4</sub> --respectivamente. Al aumentar el valor de la composición " X ", el grado de monoclinicidad disminuye gradualmente y para un -valor específico se convierte geométricamente en una simetría tetragonal. Esta transformación se realiza de una manera sua--ve y continua.

En lo que se refiere a los resultados de la medición de la conductividad eléctrica, estos sugieren que las solucio nes sólidas sintetizadas en ambos sistemas, sobre todo la de fórmula  $Li_{4-3X}Al_XGeO_4$ , podrían ser una buena opción como elec trólitos sólidos para la construcción de baterías de estado sólido.

## REFERENCIAS

- 1.- G. C. Farrington and J. L. Briant; Science, 1979, 204, 1371.
- 2.- J. Frenkel; Z. Phys. 1926, 35, 652.
- 3.- W. Schottky; Z. Phys. Chem. Abt. 1935, B 29, 335.
- 4.- H. Y. -P. Hong, Mater. Res. Bull. 13 (1978) 117 .
- 5.- A. R. West (1984). Solid State Chemistry and its Applications, John Wiley & Sons.
- 6.- A. Huanosta, Revista Mexicana de Física, 34 no. 2.(1988), 279-295. vertation
- 7.- A. R. West, J. Appl. Electrochem. 3(1973) 327.
- 8.- R. D. Shannon, B. E. Taylor, A. D. English and T. Berzins, Electrochem. Acta 22 (1977) 783.

9.- J. Kuwano and A. R. West, Matter. Res. Bull. 15 (1980) 1661. 10.- A. R. Rodger, J. Kuwano and A. R. West, Solid State Ionics

UN15 (1985) 185D AUTÓNOMA DE NUEVO LEON 11.- K. Jackowska and A. R. West, J. Mat. Sci. 18 (1983) 2380<sup>®</sup>.

- 12.- P. Quintana, F. Velasco and A. R. West, Solid State Ionics 34 (1989) 149 .
- 13.- Y. -W. Hu, I. D. Raistrick and R. A. Huggins, J. Electrochem. Soc. 124 (1977) 1240 .

14.- B. L. Dubey and A. R. West, J. Inorg. Nucl. Chem., in press

- 15.- H. Völlenke, A. Wittmann and H. Nowitny, Monat. Chem., 99 (1968) 1360 .
- 16.- A. R. West, J. of Applied Electrochemistry, 3 (1973) 327.
- 17.- B. D. Cullity, Elements of X Ray Diffraction (Massachusetts) Adison - Wesley Publishing Company, Inc., (1978).

- 18.- P. Quintana and A. R. West, J. of Solid State Chemistry, 81, 257 - 270 (1989) .
- 19.- P. G. Bruce and A. R. West, J. Electrochem. Soc. 130 (1983) 662 .
- 20.- I. M. Hodge, M. D. Ingram and A. R. West, Journal of the American Ceramic Society, 59 (1976) 7, 8.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

